

Содержание

• Теоретическая и математическая физика

Потапов А.А., Рехвиашвили С.Ш.

Моделирование некоторых свойств изображений с атомарным разрешением в сканирующем зондовом микроскопе (01) 803

• Газы и жидкости

Кашеваров А.В., Левченко В.С., Миллер А.Б., Потапов Ю.Ф., Стасенко А.Л.

К гидротермодинамике обледенения профиля в воздушно-кристаллическом потоке (03) 808

• Плазма

Богданов А.А., Каплан В.Б., Марциновский А.М.

Короткий разряд с термоэмиссионным катодом в парах щелочноземельных металлов (04) 815

Белоплотов Д.В., Ломаев М.И., Сорокин Д.А., Тарасенко В.Ф.

Стримеры при субнаносекундном пробое аргона и азота в неоднородном электрическом поле при обеих полярностях (04) 819

Алмазова К.И., Белоногов А.Н., Боровков В.В., Горелов Е.В., Морозов И.В., Тренькин А.А., Харитонов С.Ю.

Микроструктура искрового разряда в воздухе в промежутке острей — плоскость (04) 827

Мокров М.С., Райзер Ю.П.

Заполнение плоского щелевого объема тлеющим разрядом в поперечном магнитном поле и влияние магнитного поля на контракцию разряда (04) 832

• Твердое тело

Пульнев С.А., Прядко А.И., Ястребов С.Г., Николаев В.И.

Эффект памяти формы в монокристаллах Cu—Al—Ni, линейные и вращательные двигатели на их основе (05) 843

Брантов С.К., Ефимов В.Б.

О возможности разрастания алмазов в среде углеводородов (06) 850

Зуев Л.Б., Данилов В.И., Баранникова С.А., Плосков Н.А.

Природа упругопластического инварианта деформации (05) 855

• Физическое материаловедение

Соловьев Е.М., Спицын Б.В., Лаптев Р.С., Лидер А.М., Бордулев Ю.С., Михайлов А.А.

Исследование вакансионной системы реструктурированного цинка методом аннигиляции позитронов (06) 860

Дюрягина Н.С., Яловец А.П.

Радиационная электропроводность нанокмпозиционных материалов (06) 864

• Твердотельная электроника

Амеличев В.В., Беяков П.А., Костюк Д.В., Васильев Д.В., Орлов Е.П., Казаков Ю.В., Касаткин С.И., Крикунов А.И.

Создание совмещенной технологии спин-вентильных магниторезистивных элементов и микромагнитов (07) 874

• Физика низкоразмерных структур

Ильинский А.В., Кастро Р.А., Никулин Е.И., Шадрин Е.Б.

Диэлектрическая спектроскопия сильно коррелированных электронных состояний диоксида ванадия (08) 877

Данилаев М.П., Зуева Е.М., Богослов Е.А., Пудовкин М.С., Польский Ю.Е.

Механизм образования клатратов аргона с углеродными дендритами (08) 883

• Оптика

Скиданов Р.В., Моисеев О.Ю., Ганчевская С.В.

Формирование микротурбин методом прямой лазерной записи по фоторезисту (09) 888

Звездин Н.Ю., Папорков В.А., Проказников А.В., Царев И.С.

Анализ вкладов различных факторов в магнитооптический сигнал трехмерных структур типа магнитофотонных кристаллов (09) 892

• Акустика, акустоэлектроника

Антонов С.Н., Филатов А.Л.

Акустооптическая дифракция в парателлурите на медленной акустической моде. Повышение эффективности дифракции расходящегося света (10) 902

● **Радиофизика**

Терещенко Е.Д., Терещенко П.Е., Сидоренко А.Е., Григорьев В.Ф., Жамалетдинов А.А.

Влияние ионосферы на возбуждение электромагнитного поля диапазона КНЧ и более низких частот в ближней зоне (11) 907

● **Электрофизика, электронные и ионные пучки, физика ускорителей**

Щукин В.Г., Константинов В.О., Морозов В.С.

Высокоэффективный источник электронов с полым катодом для технологий осаждения тонких пленок и обработки поверхностей при форвакуумных давлениях (12) 914

● **Физическая электроника**

Булярский С.В., Дудин А.А., Лакалин А.В., Орлов А.П., Павлов А.А., Рязанов Р.М., Шаманаев А.А.

Стабильность полевой эмиссии одиночной углеродной нанотрубки (13) 920

Селюков Р.В., Наумов В.В., Васильев С.В.

Влияние толщины пленки Pt на процессы роста зерен при ее отжиге (13) 926

● **Биомедицинская физика**

Вонти А.О., Ильинский А.В., Капралова В.М., Шадрин Е.Б.

Комплексная природа термических фазовых превращений в растворах альбумина (14) 934

● **Физические приборы и методы эксперимента**

Бахолдин С.И., Маслов В.Н.

Метод видеогониографии для изучения морфологии боковой поверхности профилированных монокристаллов и прибор для его реализации (15) 943

● **Краткие сообщения**

Соснин Э.А., Панарин В.А., Скакун В.С., Тарасенко В.Ф.

К вопросу об источнике апокампа (04) 951

Иванов П.А., Потапов А.С., Грехов И.В.

Влияние частичной ионизации легирующих примесей в 4H-SiC на емкость обратносмещенного p^+-i-n^+ -диода (07) 955